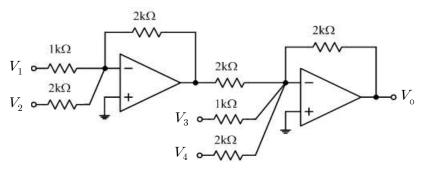
① 30°

전 자 공 학 개 론

1. 이상적인 연산 증폭기(operational amplifier)를 사용하여 구현한 다음 회로에서 출력전압 V_0 를 옳게 표현한 식은?

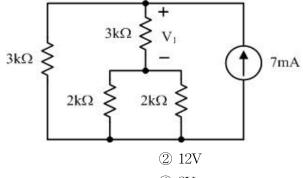


- ① $V_0 = 2V_1 V_2 2V_3 + V_4$
- ② $V_0 = -2V_1 V_2 + 2V_3 + V_4$
- $V_0 = 0.5V_1 V_2 0.5V_3 + V_4$
- $(5) V_0 = 2V_1 + V_2 2V_3 V_4$
- 2. 다음 카르노 맵(Karnaugh map)을 표현한 논리식으로 옳은 것은? (단, X 는 don't care condition을 나타낸다.)

CD AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	X	1
11	1	0	X	1
10	0	1	1	0

- ① BD' + B'D
- ② B'D+D
- 3B'D+B
- 4 B'D' + BD

- ⑤ *BD*
- 3. 다음 회로에서 전압 V_1 의 값은?

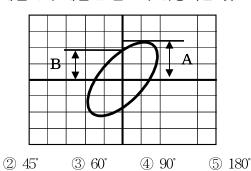


- ① 21V
- 3 9V

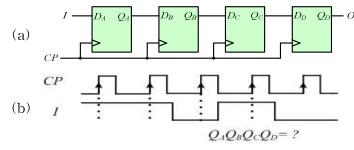
4 8V

⑤ 6V

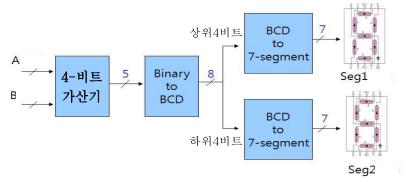
4. 오실로스코프로 다음 그림과 같은 리사쥬 파형이 측정되었다. 리사쥬에서 A의 크기가 2이고, B의 크기가 √3일 때, 동일한 주파수를 갖는 채널 1과 채널 2 신호의 위상차는 몇 도인가?



5. 다음 그림 (a)와 같은 4비트 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터에 데이터 입력(I)과 클릭파형(CP)을 공급하였다. 그림 (b)에서와 같이 클릭펄스 상승에지(rising edge)가 4회 인가되었을 때 $Q_A \ Q_B \ Q_C \ Q_D$ 의 논리 상태 값을 옳게 나타낸 것은?



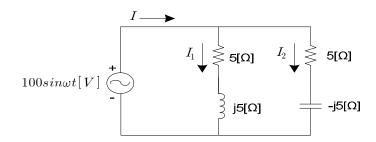
- ① $Q_A Q_B Q_C Q_D = \text{``0101''}$
- ② $Q_A Q_B Q_C Q_D = "1011"$
- $\bigoplus Q_A Q_B Q_C Q_D = "0111"$
- \bigcirc $Q_A Q_B Q_C Q_D = "0011"$
- 6. 다음 그림에서 입력 A와 B에 10진수 9에 해당하는 4-비트 2진수와 10진수 8에 해당하는 4-비트 2진수가 각각 입력되었다면, "BCD to 7-segment"로 입력되는 상위4비트와 하위4비트 각각의 값은?



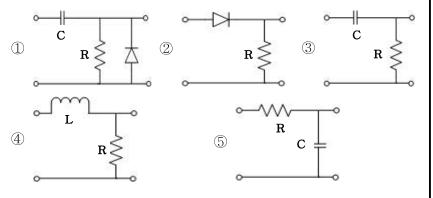
- ① 상위 4비트 = "1001", 하위 4비트 = "1000"
- ② 상위 4비트 = "0001", 하위 4비트 = "0111"
- ③ 상위 4비트 = "0010", 하위 4비트 = "1111"
- ④ 상위 4비트 = "1111", 하위 4비트 = "0010"
- ⑤ 상위 4비트 = "0100", 하위 4비트 = "1111"

전 자 공 학 개 론

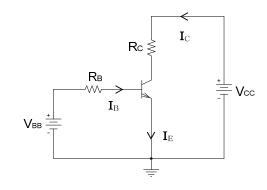
7. 다음 그림과 같은 회로에서 $100sin\omega t[V]$ 의 교류전압이 인가될 때 회로에 흐르는 각 가지의 전류 (I_1,I_2,I) 의 값[A]을 옳게 나 타낸 것은?



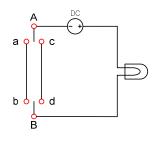
- $\textcircled{1} \ I_1 = 10 \sqrt{2} \sin(\omega t \frac{\pi}{4}), \ I_2 = 10 \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}), \ I = 20 \sin\omega t$
- ② $I_1 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{4}), I_2 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t \frac{\pi}{4}), I = 20\sin\omega t$
- ③ $I_1 = 10\sqrt{2}\sin\omega t$, $I_2 = 10\sqrt{2}\sin\omega t$, $I = 20\sqrt{2}\sin\omega t$
- $\textcircled{4} \ I_1 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}), \ I_2 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t \frac{\pi}{2}), \ I = 20\sin\omega t$
- 8. 다음 중 직류 전원회로의 기본 구성 순서를 옳게 나타낸 것은?
 - ① 입력→정류기→변압기→필터→정전압회로→부하
 - ② 입력→필터→변압기→정류기→정전압회로→부하
 - ③ 입력→정류기→필터→정전압회로→변압기→부하
 - ④ 입력→변압기→정류기→필터→정전압회로→부하
 - ⑤ 입력→정전압회로→정류기→필터→변압기→부하
- 9. 다음의 다단증폭기에 관한 설명 중 옳게 나타낸 것은?
 - ① CC-CE 종속 연결 증폭기는 출력저항을 크게 하기 위해 사용된다.
 - ② CE-CC 종속 연결 증폭기는 출력저항이 매우 크다.
 - ③ CC-CC 종속 연결 증폭기는 매우 큰 전압이득을 얻을 수 있다.
 - ④ 전체 전압이득은 각 증폭단의 전압이득을 합한 것이다.
 - (5) CE-CB 종속 연결 증폭기는 고주파영역에서 우수한 성능을 갖는다.
- 10. 다음 회로 중에서 입력 파형을 특정한 레벨에 고정시키고 입력 펄 스 파형을 그대로 유지하거나 직류 성분을 재생하는 능력을 가지 는 회로를 옳게 나타낸 것은?



- 11. 임피던스의 리액턴스 성분을 설명한 것 중 옳은 것만 고른 것은?
 - ㄱ. 교류에 대하여 코일이 제공하는 저항성을 유도 리액턴스 (Inductive Reactance)라고 한다.
 - L. 용량 리액턴스(Capacitive Reactance)는 교류 주파수가 클수록 커진다.
 - ㄷ. 직류에서는 유도 리액턴스가 ∞이다.
 - ㄹ. 용량 리액턴스와 유도 리액턴스가 서로 상쇄될 때 공진현상이
 - ① 7, L ② 7, E ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ
- 12. 다음 회로와 같은 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT: Bipolar Junction Transistor)를 선형영역에서 동작시키고자 할 때 바이어스 동작에 관한 옳은 설명을 모두 고른 것은?



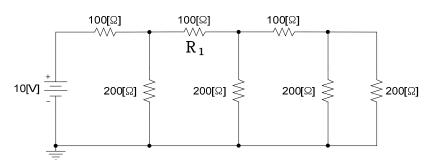
- 기. 그림에서의 트랜지스터는 NPN 트랜지스터이다.
- ㄴ. 베이스-이미터 접합이 순방향 바이어스가 되도록 V_{RB} 값을
- ㄷ. 컬렉터 전류 (I_C) 는 베이스 전류 (I_B) 와 이미터 전류 (I_E) 를 합한
- ㄹ. V_{CC} 를 V_{BB} 보다 크게 설정하는 이유는 베이스-컬렉터 접합이 역방향 바이어스가 되도록 만들기 위한 것이다.
- ① 7. L ② 7. L ③ L, Z ④ 7. L, Z ⑤ L, C, Z
- 13. 다음 그림에서 스위치 A는 계단 위층에, 스위치 B는 계단 아래층 에 설치되어 있다. 스위치 A와 B의 접점 상태를 나타낸 진리표에 대해 램프의 점멸상태를 논리식(F)으로 옳게 표현한 것은? (단, a, b 접점은 0으로, c, d 접점은 1로 하여 풀이 하시오)



스위치 A	스위치 B	램프
a	b	ON
a	d	OFF
С	b	OFF
С	d	ON

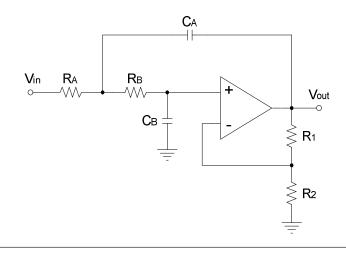
- ① F = A'B' + AB
- \bigcirc F = A'B + AB'
- ③ F = (A' + A)'
- 4 F = (A + B')'
- ⑤ F = A + B

14. 다음 그림과 같이 저항을 직·병렬로 구성한 회로에서 저항 R_1 이 소비하는 전력[mW] 은?



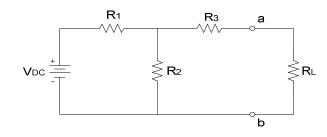
- ① 31.25
- 2 62.5
- ③ 125
- ④ 250
- ⑤ 500

15. 다음 그림은 이상적인 연산증폭기를 이용한 능동필터회로이다. 회로에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?



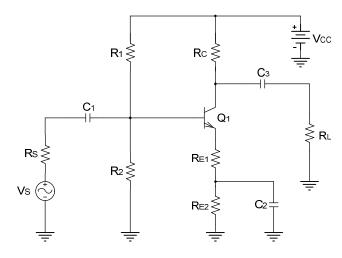
- □. 저주파에서 1차 필터보다 더 가파른 감쇄특성을 얻기 위한 2차 고역통과필터(High Pass Filter)이다.
- ㄴ. $R_A=R_B=R$ 이고 $C_A=C_B=C$ 인 경우 차단주파수는 $f_c=\frac{1}{2\pi RC}$ 이다.
- \Box . 저항 R_1 과 저항 R_2 는 능동필터의 전압이득 조정에 사용된다.
- 1 _
- ② ¬, ∟
- ③ ¬, ⊏
- ④ ∟, ⊏
- ⑤ 7, ∟, ⊏

16. 다음 그림과 같은 회로에서 단자 a-b 좌측을 테브난 등가회로로 바꾸어 해석하고자 한다. 다음 설명 중 옳은 것만 모두 고른 것은?



- ㄱ. 테브난 등가저항 $(R_{T\!H})$ 은 $R_{T\!H}=R_1+rac{R_2R_3}{R_2+R_3}[\Omega]$ 이다.
- ㄴ. 테브난 등가전압 (V_{TH}) 은 $V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{DC}[V]$ 이다.
- ㄷ. 부하저항 (R_{L}) 이 테브난 등가저항 (R_{TH}) 과 같을 때 부하에 최 대전력이 공급된다.
- ㄹ. 부하저항 (R_L) 에 공급되는 최대전력은 $P_{L(\max)} = rac{V_{TH}^2}{R_L}$ 이다.
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
- ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

17. 그림과 같은 공통 이미터(Common Emitter) 접지 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?



- ㄱ. 커패시터 C_1 과 C_3 는 각각 입력과 출력 결합 커패시터로서 전 압원(V_S)과 부하(R_L)에 대한 바이어스의 영향을 억제한다.
- 느. 증폭기의 부하에 걸리는 출력전압의 위상은 전압원의 입력위 상과 동일하다.
- ㄷ. 부하 (R_L) 의 저항값이 작아질수록 증폭기의 전압이득은 상대 적으로 커진다.
- ㄹ. 커패시터 C_2 가 단락(short)이면 직류 컬렉터 전류(I_C)는 증가한다.
- ① ¬, ∟

② ¬, ⊏

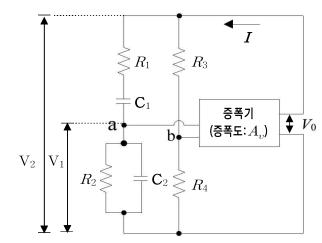
③ ㄱ, ㄹ

- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 다음 중 수와 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

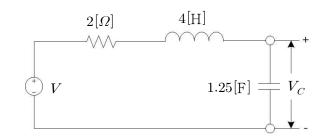
- ① 8진수 37.54를 16진수로 변환하면 1F.B이다.
- ② 해밍코드(Hamming Code)는 코드의 오류가 발생되면 이를 검출 하여 교정할 수 있도록 한 코드 이다.
- ③ $\mathrm{FF0}_{16}$ 을 16의 보수로 표현하면 $\mathrm{00F}_{16}$ 이다.
- ④ 2진 연산시 감산은 보수를 취하여 가산하는 방법으로 처리한다.
- ⑤ 10진수 0.4375를 2진수로 변환하면 0.1011,이다.

19. 다음 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 저주파용 발진에 적합하고 주파수 안정도가 우수하다.
- ② 정궤환이 되기 위해서는 V_1 과 V_2 가 동위상이고 허수부가 0이 되어야 한다.
- ③ 정궤환을 위한 위상 조건은 $wC_1R_1 \frac{1}{wC_2R_3} = 0$ 이다.
- ④ 발진을 위한 전압증폭도 A_v 는 $C_1=C_2\,,\,R_1=R_2$ 라면 $A_v\geq 3$ 이 어야 한다.
- ⑤ $C_1 = C_2 = C$, $R_1 = R_2 = R$ 일 때 $f = \frac{1}{2\pi RC}$ 이다.

20. 다음 회로의 전압비 전달함수 $H(jw) = \frac{V_C(jw)}{V(jw)}$ 를 옳게 나타낸 것은?



①
$$\frac{0.5}{(jw)^2 + 0.2(jw) + 0.5}$$

$$2 \frac{0.25}{(jw)^2 + 0.2(jw) + 0.5}$$

$$\textcircled{4} \frac{0.25}{(jw)^2 + 0.5(jw) + 0.2}$$